

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-125746

(P2013-125746A)

(43) 公開日 平成25年6月24日(2013.6.24)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>H05B 33/04 (2006.01)</b>	H05B 33/04	2H048
<b>H01L 51/50 (2006.01)</b>	H05B 33/14 A	3K107
<b>H05B 33/12 (2006.01)</b>	H05B 33/12 E	
<b>G02B 5/20 (2006.01)</b>	G02B 5/20 1O1	
<b>H05B 33/22 (2006.01)</b>	H05B 33/22 Z	

審査請求 有 請求項の数 15 O L (全 20 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2012-237516 (P2012-237516)  
 (22) 出願日 平成24年10月29日 (2012.10.29)  
 (31) 優先権主張番号 10-2011-0134862  
 (32) 優先日 平成23年12月14日 (2011.12.14)  
 (33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 501426046  
 エルジー ディ스플레이 カンパニー リミテッド  
 大韓民国 ソウル、ヨンドゥンポグ、ヨウィーテロ 128  
 (74) 代理人 100094112  
 弁理士 岡部 譲  
 (74) 代理人 100106183  
 弁理士 吉澤 弘司  
 (74) 代理人 100128657  
 弁理士 三山 勝巳  
 (74) 代理人 100160967  
 弁理士 ▲濱▼口 岳久

最終頁に続く

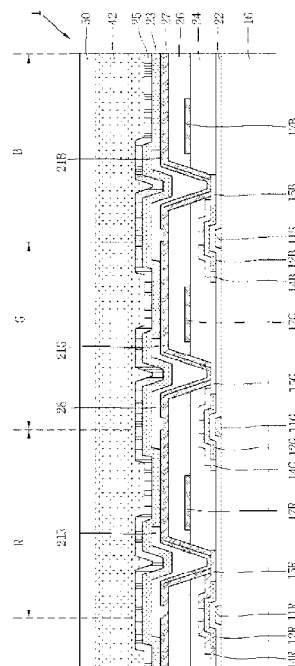
(54) 【発明の名称】 有機電界発光表示素子及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】視野角特性を向上させる光学補償層を形成する際における水素の浸透による薄膜トランジスタの劣化を防止することのできる有機電界発光表示素子及びその製造方法を提供する。

【解決手段】有機電界発光表示素子は、複数の画素を含む第1基板16及び第2基板50と、第1基板16の各画素に形成された薄膜トランジスタと、前記各画素に形成されたカラーフィルタ層17R、17G、17Bと、カラーフィルタ層17R、17G、17B上に形成された絶縁層26と、絶縁層26上に形成され、水素非含有物質からなる光学補償層27と、前記各画素の光学補償層27上に形成された画素電極21R、21G、21Bと、画素電極21R、21G、21B上に形成されて発光する有機発光部23と、有機発光部23上に形成された共通電極25とを含む。

【選択図】図2



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

複数の画素を含む第 1 基板及び第 2 基板と、  
 前記第 1 基板上に形成された薄膜トランジスタと、  
 前記薄膜トランジスタを含む前記第 1 基板上に形成された第 1 絶縁層と、  
 画素領域における前記第 1 絶縁層上に形成されたカラーフィルタ層と、  
 前記カラーフィルタ層を含む前記第 1 基板上に形成された第 2 絶縁層と、  
 前記第 2 絶縁層上に形成され、水素非含有物質からなる光学補償層であって、前記薄膜トランジスタのドレインのパッドに接した光学補償層と、  
 前記各画素領域における前記光学補償層上に形成された画素電極と、  
 前記画素電極上に形成されて発光する有機発光部と、  
 前記有機発光部上に形成された共通電極と  
 を含む、有機電界発光表示素子。

10

## 【請求項 2】

前記光学補償層に形成されて異物を排出する複数の孔をさらに含み、前記複数の穴は各画素領域における外周壁に形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示素子。

## 【請求項 3】

前記光学補償層は、透明物質からなることを特徴とする請求項 2 に記載の有機電界発光表示素子。

20

## 【請求項 4】

前記光学補償層は、 $\text{SiN}_x$ 、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide) からなる群から選択された物質で形成されることを特徴とする請求項 3 に記載の有機電界発光表示素子。

## 【請求項 5】

前記  $\text{SiN}_x$  は、1500 ~ 2000 の厚さで積層されることを特徴とする請求項 4 に記載の有機電界発光表示素子。

## 【請求項 6】

前記複数の孔は、カラーフィルタに対応する領域に形成されることを特徴とする請求項 5 に記載の有機電界発光表示素子。

30

## 【請求項 7】

前記複数の孔は、カラーフィルタに対応する領域及びカラーフィルタ領域内に形成されることを特徴とする請求項 5 に記載の有機電界発光表示素子。

## 【請求項 8】

複数の画素を含む第 1 基板及び第 2 基板を準備する段階と、  
 前記第 1 基板の各画素に薄膜トランジスタを形成する段階と、  
 前記薄膜トランジスタを含む前記第 1 基板上に第 1 絶縁層を形成する段階と、  
 画素領域における前記第 1 絶縁層上にカラーフィルタ層を形成する段階と、  
 前記カラーフィルタ層を含む前記第 1 基板上に第 2 絶縁層を形成する段階と、  
 $\text{SiH}_4$  と  $\text{N}_2$  を混合したガス雰囲気中で  $\text{SiN}_x$  からなるとともに水素非含有物質からなる光学補償層を前記第 2 絶縁層上に形成する段階であって、前記光学補償層は前記薄膜トランジスタのドレインのパッドに接する段階と、  
 前記各画素領域における前記光学補償層上に画素電極を形成する段階と、  
 前記光学補償層上に光を発光する有機発光部を形成する段階と、  
 前記有機発光部上に共通電極を形成する段階と、  
 前記第 1 基板と前記第 2 基板とを貼り合わせる段階と  
 を含む、有機電界発光表示素子の製造方法。

40

## 【請求項 9】

前記光学補償層をエッチングして複数の孔を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項 8 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

50

**【請求項 10】**

前記  $\text{SiN}_x$  は、透明性を有することを特徴とする請求項 9 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

**【請求項 11】**

$\text{SiH}_4$  と  $\text{NH}_3$  を混合したガス雰囲気中で  $\text{SiN}_x$  層を形成する段階をさらに含み、 $\text{SiH}_4$  と  $\text{N}_2$  を混合したガス雰囲気及び  $\text{SiH}_4$  と  $\text{NH}_3$  を混合したガス雰囲気に交互に切り替えて  $\text{SiN}_x$  層を形成することを特徴とする請求項 10 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

**【請求項 12】**

前記画素電極を形成する段階の後に、形成された層を所定時間の間真空状態で真空キュアして、前記形成された層に含まれる異物を前記孔から排出する段階をさらに含むことを特徴とする請求項 11 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

10

**【請求項 13】**

前記光学補償層は透明物質からなることを特徴とする請求項 8 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

**【請求項 14】**

前記光学補償層は、 $\text{SiN}_x$ 、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide) からなる群から選択された物質で形成されることを特徴とする請求項 8 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

**【請求項 15】**

前記画素電極を形成する段階の後に、形成された層を所定時間の間真空状態で真空キュアして、前記形成された層に含まれる異物を前記孔から排出する段階をさらに含むことを特徴とする請求項 8 に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

20

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、有機電界発光表示素子に関し、特に、色視野角を改善することのできる有機電界発光表示素子及びその製造方法に関する。

**【背景技術】****【0002】**

近年、共役高分子の 1 つであるポリ (p - フェニレンビニレン) (PPV) を用いた有機電界発光素子が開発されるにつれて、導電性を有する共役高分子などの有機物に関する研究が盛んに行われている。また、導電性を有する共役高分子などの有機物を薄膜トランジスタ、センサ、レーザ、光電素子などに応用するための研究も継続して行われており、とりわけ有機電界発光表示素子に関する研究が最も盛んに行われている。

30

**【0003】**

燐光物質系無機物からなる電界発光素子の場合、交流 200V 以上の作動電圧を必要とし、素子製造工程が真空蒸着により行われるため、大型化が難しく、特に青色発光が難しいだけでなく、製造コストが高いという欠点があった。それに対して、有機物からなる電界発光素子は、優れた発光効率、大面積化の容易性、及び工程の簡便性を有し、特に青色発光が容易に得られ、折り曲げ可能な電界発光素子を開発できるという利点などにより、次世代表示装置として脚光を浴びている。

40

**【0004】**

現在は、液晶表示装置と同様に各画素に能動型駆動素子を備えたアクティブマトリクス有機電界発光表示素子が、フラットパネルディスプレイとして盛んに研究されている。特に、近年は、カラーを実現するためのカラーフィルタ層を薄膜トランジスタが形成される基板に形成し、発光部から発光した光がカラーフィルタ層を透過することによりカラーを表示するようにしている。

**【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】**

50

## 【 0 0 0 5 】

しかし、このようなCOT (Color Filter on TFT) 構造の有機電界発光表示素子においては、視野方向によって色変換が生じて視野角が狭くなるという問題があった。

## 【 0 0 0 6 】

本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、光学補償層を形成して視野角特性を向上させることのできる有機電界発光表示素子及びその製造方法を提供することを目的とする。

## 【 0 0 0 7 】

本発明の他の目的は、光学補償層を水素非含有ガス雰囲気中で形成して、光学補償層を形成する際における薄膜トランジスタのチャンネル層への水素の浸透による薄膜トランジスタの劣化を防止することのできる有機電界発光表示素子及びその製造方法を提供することにある。

10

## 【 0 0 0 8 】

本発明のさらに他の目的は、光学補償層に異物排出用孔を形成して、真空キュア (vacuum cure) 時に異物を円滑に排出することのできる有機電界発光表示素子及びその製造方法を提供することにある。

## 【 課題を解決するための手段 】

## 【 0 0 0 9 】

上記目的を達成するために、本発明による有機電界発光表示素子は、複数の画素を含む第1基板及び第2基板と、前記第1基板上に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを含む前記第1基板上に形成された第1絶縁層と、画素領域における前記第1絶縁層上に形成されたカラーフィルタ層と、前記カラーフィルタ層を含む前記第1基板上に形成された第2絶縁層と、前記第2絶縁層上に形成され、水素非含有物質からなる光学補償層であって、前記薄膜トランジスタのドレインのパッドに接した光学補償層と、前記各画素領域における前記光学補償層上に形成された画素電極と、前記画素電極上に形成されて発光する有機発光部と、前記有機発光部上に形成された共通電極とを含む。

20

## 【 0 0 1 0 】

前記光学補償層は、屈折率  $1.5 \sim 2.7$  の  $\text{SiNx}$ 、ITO (Indium Tin Oxide)、又はIZO (Indium Zinc Oxide) などで形成される。前記  $\text{SiNx}$  は、 $1500 \sim 2000$  の厚さで積層される。前記光学補償層には複数の孔が形成されており、真空キュア時に異物を排出する。

30

## 【 0 0 1 1 】

また、本発明による有機電界発光表示素子の製造方法は、複数の画素を含む第1基板及び第2基板を準備する段階と、前記第1基板の各画素に薄膜トランジスタを形成する段階と、前記薄膜トランジスタを含む前記第1基板上に第1絶縁層を形成する段階と、画素領域における前記第1絶縁層上にカラーフィルタ層を形成する段階と、前記カラーフィルタ層を含む前記第1基板上に第2絶縁層を形成する段階と、 $\text{SiH}_4$  と  $\text{N}_2$  を混合したガス雰囲気中で  $\text{SiNx}$  からなるとともに水素非含有物質からなる光学補償層を前記第2絶縁層上に形成する段階であって、前記光学補償層は前記薄膜トランジスタのドレインのパッドに接する段階と、前記各画素領域における前記光学補償層上に画素電極を形成する段階と、前記光学補償層上に光を発光する有機発光部を形成する段階と、前記有機発光部上に共通電極を形成する段階と、前記第1基板と前記第2基板とを貼り合わせる段階とを含む。

40

## 【 0 0 1 2 】

本発明による有機電界発光表示素子の製造方法は、 $\text{SiH}_4$  と  $\text{NH}_3$  を混合したガス雰囲気中で  $\text{SiNx}$  層を形成する段階をさらに含み、 $\text{SiH}_4$  と  $\text{N}_2$  を混合したガス雰囲気及び  $\text{SiH}_4$  と  $\text{NH}_3$  を混合したガス雰囲気に交互に切り替えて  $\text{SiNx}$  層を形成する。

## 【 0 0 1 3 】

本発明による有機電界発光表示素子の製造方法は、前記光学補償層をエッチングして複数の孔を形成する段階をさらに含む。

## 【 0 0 1 4 】

50

本発明による有機電界発光表示素子の製造方法は、前記画素電極を形成する段階の後に、形成された層を所定時間の間真空状態で真空キュアして、前記形成された層に含まれる異物を前記孔から排出する段階をさらに含む。

【0015】

前記光学補償層は、屈折率1.5～2.7の透明物質からなる。

【発明の効果】

【0016】

本発明においては次のような効果が得られる。

【0017】

第一に、本発明においては、1.5～2.7の屈折率を有する透明な光学補償層を形成することにより、視野角特性を向上させることができる。

10

【0018】

第二に、本発明においては、前記光学補償層を水素非含有ガス雰囲気中で形成することにより、前記光学補償層を形成する際に薄膜トランジスタのチャンネル層に水素が浸透することを防止することができ、水素の浸透による薄膜トランジスタの劣化を防止することができる。

【0019】

第三に、本発明においては、前記光学補償層に異物排出用孔を形成して真空キュア時に異物を円滑に排出することにより、異物による不良を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

20

【0020】

【図1】本発明による有機電界発光表示素子の等価回路図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子の構造を示す断面図である。

【図3A】本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子の製造方法を示す図である。

【図3B】図3Aに続く工程を示す図である。

【図3C】図3Bに続く工程を示す図である。

【図3D】図3Cに続く工程を示す図である。

【図3E】図3Dに続く工程を示す図である。

30

【図3F】図3Eに続く工程を示す図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態による有機電界発光表示素子の構造を示す断面図である。

【図5A】本発明の第2の実施の形態による有機電界発光表示素子の製造方法を示す図である。

【図5B】図5Aに続く工程を示す図である。

【図5C】図5Bに続く工程を示す図である。

【図5D】図5Cに続く工程を示す図である。

【図5E】図5Dに続く工程を示す図である。

【図5F】図5Eに続く工程を示す図である。

40

【発明を実施するための形態】

【0021】

以下、添付図面を参照して本発明について詳細に説明する。

【0022】

図1は、本発明による有機電界発光表示素子の等価回路図である。図1に示すように、本発明による有機電界発光表示素子1は、縦横に交差するゲートラインG及びデータラインDにより定義される複数の画素からなり、各画素内にはパワーラインPがデータラインDと平行に配列されている。

【0023】

各画素内には、スイッチング薄膜トランジスタTs、駆動薄膜トランジスタTd、キャ

50

パシタC、及び発光素子Eが備えられる。スイッチング薄膜トランジスタTsのゲート電極はゲートラインGに接続され、スイッチング薄膜トランジスタTsのソース電極はデータラインDに接続され、スイッチング薄膜トランジスタTsのドレイン電極は駆動薄膜トランジスタTdのゲート電極に接続されている。また、駆動薄膜トランジスタTdのソース電極はパワーラインPに接続され、駆動薄膜トランジスタTdのドレイン電極は発光素子Eに接続されている。

【0024】

このような構成の有機電界発光表示素子1においては、走査信号がゲートラインGに入力されることにより、スイッチング薄膜トランジスタTsのゲート電極に信号が供給されて、スイッチング薄膜トランジスタTsが駆動される。そして、スイッチング薄膜トランジスタTsが駆動されることにより、データラインDに入力されるデータ信号がソース電極及びドレイン電極を介して駆動薄膜トランジスタTdのゲート電極に入力されて、駆動薄膜トランジスタTdが駆動される。

10

【0025】

このとき、パワーラインPには電流が流れ、駆動薄膜トランジスタTdが駆動されることにより、パワーラインPの電流がソース電極及びドレイン電極を介して発光素子Eに供給される。ここで、駆動薄膜トランジスタTdを介して出力される電流の大きさは、ゲート電極とドレイン電極間の電圧によって変化する。

【0026】

発光素子Eは、有機発光素子であって、駆動薄膜トランジスタTdを介して電流が入力されることにより発光して画像を表示する。ここで、発光する光の強さは供給される電流の強さによって変化するので、電流の強さを調節することにより光の強さを調節することができる。

20

【0027】

図2は、本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子の構造を示す断面図である。同図を参照して本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子の構造を説明する。

【0028】

図2に示すように、本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子は、赤色光を出力するR画素、緑色光を出力するG画素、及び青色光を出力するB画素からなる。図示していないが、本発明による有機電界発光表示素子は、白色光を出力するW画素を含んでもよい。この場合、W画素から白色光を出力することにより、有機電界発光表示素子の全体輝度を向上させることができる。

30

【0029】

R、G、B画素にはそれぞれカラーフィルタ層が形成されており、有機発光部から出力される白色光を特定のカラーの光にして出力するが、W画素を含む場合、W画素は、カラーフィルタ層を必要とせず、発光した白色光をそのまま出力する。

【0030】

図2に示すように、ガラスやプラスチックなどの透明物質からなる第1基板16はR、G、B画素に分けられ、R、G、B画素にはそれぞれ駆動薄膜トランジスタが形成されている。

40

【0031】

前記駆動薄膜トランジスタは、第1基板16上のR、G、B画素にそれぞれ形成されたゲート電極11R、11G、11Bと、ゲート電極11R、11G、11B上に形成された半導体層12R、12G、12Bと、半導体層12R、12G、12B上に形成されたソース電極14R、14G、14B及びドレイン電極15R、15G、15Bとからなる。図示していないが、半導体層12R、12G、12Bの上面の一部にはエッチングストッパが形成されており、ソース電極14R、14G、14B及びドレイン電極15R、15G、15Bのエッチング工程中に半導体層12R、12G、12Bがエッチングされることを防止するようにしてもよい。

50

## 【0032】

ゲート電極11R、11G、11Bは、Cr、Mo、Ta、Cu、Ti、Al、又はAl合金などの金属で形成してもよい。また、ゲート絶縁層22は、SiO<sub>2</sub>やSiNxなどの無機絶縁物質からなる単一層でもよく、SiO<sub>2</sub>及びSiNxからなる二重層でもよい。半導体層12R、12G、12Bは、非晶質シリコン(a-Si)、結晶質半導体、IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) などの透明酸化物半導体、又は有機物半導体で形成してもよい。また、ソース電極14R、14G、14B及びドレイン電極15R、15G、15Bは、Cr、Mo、Ta、Cu、Ti、Al、又はAl合金などの金属で形成してもよい。

## 【0033】

前記駆動薄膜トランジスタが形成された第1基板16には第1絶縁層24が形成される。第1絶縁層24は、SiO<sub>2</sub>などの無機絶縁物質を用いて約4500の厚さで形成してもよい。第1絶縁層24上のR、G、B画素には、それぞれRカラーフィルタ層17R、Gカラーフィルタ層17G、Bカラーフィルタ層17Bが形成される。

## 【0034】

Rカラーフィルタ層17R、Gカラーフィルタ層17G、Bカラーフィルタ層17B上には第2絶縁層26が形成される。第2絶縁層26は、第1基板16平坦化するためのオーバーコート層であり、フオトアクリルなどの有機絶縁物質を用いて約3μmの厚さで形成してもよい。

## 【0035】

第2絶縁層26上には光学補償層27が形成される。光学補償層27は、カラーフィルタ層17R、17G、17Bに入力される光を屈折させて光の視野角特性を向上させるためのものであり、屈折率1.5~2.7のSiNx層を1500~2000の厚さで積層することにより形成してもよい。光学補償層27は、SiNx層に限定されるものではなく、屈折率1.5~2.7の透明物質であればいかなる物質でも使用可能である。例えば、透明なITOやIZOを使用して光学補償層27を形成してもよい。ここで、光学補償層27は、第1基板16全体にわたって形成されるので、ITOやIZOの組成比を調節して電気伝導度を最小限に抑えることで導電性を除去することが好ましい。

## 【0036】

ここで、光学補償層27は、水素を含有しない層であり、例えば光学補償層27としてSiNx層を形成する際に、水素を含まない雰囲気中で形成することにより、薄膜トランジスタのチャネル層に水素が浸透して薄膜トランジスタが劣化することを防止することができる。

## 【0037】

光学補償層27上のR、G、B画素にはそれぞれ画素電極21R、21G、21Bが形成される。このとき、R、G、B画素にそれぞれ形成された駆動薄膜トランジスタのドレイン電極15R、15G、15Bの上部の第1絶縁層24及び第2絶縁層26にはコンタクトホール29(図3D参照)が形成されており、光学補償層27及び画素電極21R、21G、21Bがコンタクトホール29に形成され、画素電極21R、21G、21Bは、それぞれ露出した駆動薄膜トランジスタのドレイン電極15R、15G、15Bと電氣的に接続される。

## 【0038】

また、第2絶縁層26上の各画素境界領域にはバンク層(bank layer)28が形成される。バンク層28は、一種の隔壁であり、各画素を区画して隣接する画素から出力される特定のカラーの光が混合されて出力されることを防止するためのものである。また、バンク層28は、コンタクトホール29の一部を埋めて段差を減少させ、その結果、有機発光部23を形成する際に、過度な段差により有機発光部23に不良が発生することを防止する。

## 【0039】

画素電極21R、21G、21Bは、ITOやIZOなどの透明な酸化金属物質からな

10

20

30

40

50

るが、本発明においては、画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B をそれぞれの R、G、B 画素に約 5 0 0 の厚さで形成してもよい。

【0040】

画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B は光学補償層 2 7 に直接接触する。従って、光学補償層 2 7 を I T O や I Z O で形成した場合、画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B に供給される信号が第 1 基板 1 6 全体にわたって供給されるので、光学補償層 2 7 の I T O や I Z O は、画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B の I T O や I Z O に比べて電気伝導度をはるかに低くする。

【0041】

有機発光部 2 3 は、白色光を発光する白色有機発光層を含む。前記白色有機発光層は、R、G、B の単色光をそれぞれ発光する複数の有機物質を混合して形成してもよく、R、G、B の単色光をそれぞれ発光する複数の発光層を積層して形成してもよい。図示していないが、有機発光部 2 3 には、有機発光層に加えて、有機発光層にそれぞれ電子及び正孔を注入する電子注入層及び正孔注入層、並びに有機発光層にそれぞれ電子及び正孔を輸送する電子輸送層及び正孔輸送層が形成されてもよい。

10

【0042】

有機発光部 2 3 上には、第 1 基板 1 6 全体にわたって共通電極 2 5 が形成される。共通電極 2 5 は、C a、B a、M g、A l、A g などからなる。

【0043】

ここで、共通電極 2 5 は有機発光部 2 3 のカソードであり、画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B は有機発光部 2 3 のアノードであり、共通電極 2 5 と画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B に電圧が印加されると、共通電極 2 5 からは有機発光部 2 3 に電子が注入され、画素電極 2 1 R、2 1 G、2 1 B からは有機発光部 2 3 に正孔が注入されることにより、有機発光層内に励起子が生成され、その励起子が消滅すると、有機発光層の L U M O (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) と H O M O (Highest Occupied Molecular Orbital) のエネルギー差に相当する光が発生し、外部 (図 2 の第 1 基板 1 6 側) に発散する。このとき、有機発光層に含まれる R、G、B 発光層からそれぞれ赤色光、緑色光、青色光が発光し、これらの光が混合されて白色光が発散する。そして、発散した白色光は、それぞれ R、G、B カラーフィルタ層 1 7 R、1 7 G、1 7 B を透過し、該当画素に対応するカラーの光のみが出力される。

20

30

【0044】

共通電極 2 5 上に接着剤が塗布されて接着層 4 2 が形成され、接着層 4 2 上に第 2 基板 5 0 が配置され、接着層 4 2 により第 2 基板 5 0 が第 1 基板 1 6 に貼り付けられる。

【0045】

前記接着剤としては、接着力、耐熱性、及び耐水性に優れた物質であればいかなる物質でも使用可能であるが、本発明においては、主にエポキシ系化合物、アクリレート系化合物、又はアクリル系ゴムなどの熱硬化性樹脂を使用する。ここで、接着層 4 2 は、約 5 ~ 1 0 0  $\mu$ m の厚さで塗布され、約 8 0 ~ 1 7 0 度の温度で硬化する。接着層 4 2 は、第 1 基板 1 6 と第 2 基板 5 0 とを貼り合わせる役割を果たすだけでなく、前記有機電界発光表示素子の内部に水分が浸透することを防止するための封止剤の役割も果たす。つまり、本発明の詳細な説明においては符号 4 2 を接着層という用語で表現するが、これは説明の便宜のためであり、当該接着層を封止層と表現してもよい。

40

【0046】

第 2 基板 5 0 は、接着層 4 2 を封止するための封止キャップ (encapsulation cap) であって、P S (Polystyrene) フィルム、P E (Polyethylene) フィルム、P E N (Polyethylene Naphthalate) フィルム、又は P I (Polyimide) フィルムなどの保護フィルムからなるようにしてもよい。また、第 2 基板 5 0 としては、ガラスやプラスチックを使用してもよく、第 1 基板 1 6 に形成された構成物を保護できればいかなる物質でも使用可能である。

【0047】

50

図示していないが、前記有機電界発光表示素子の外郭領域における第1基板16と第2基板50との間には、共通電極25に共通電圧を供給する補助電極が形成されてもよい。

【0048】

前述したように、本発明においては、有機発光部23の下部に光学補償層27を形成することにより、有機発光部23からR、G、Bカラーフィルタ層17R、17G、17Bに入射する白色光を補償し、視野角特性を向上させる。

【0049】

ここで、光学補償層27は、水素非含有層からなるため、光学補償層27を形成する際に薄膜トランジスタのチャンネル層に水素が浸透して薄膜トランジスタが劣化することを防止することができる。

【0050】

以下、このような構造の本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子の製造方法を説明する。

【0051】

図3A～図3Fは、本発明の第1の実施の形態による有機電界発光表示素子の製造方法を示す図である。

【0052】

まず、図3Aに示すように、ガラスやプラスチックなどの透明物質からなる第1基板16を準備し、その上にCr、Mo、Ta、Cu、Ti、Al、又はAl合金のように導電性に優れた不透明金属をスパッタリング法により積層し、フォトリソグラフィ法によりエッチングして、ゲート電極11R、11G、11Bを形成する。

【0053】

その後、ゲート電極11R、11G、11Bが形成された第1基板16全体にわたってCVD (Chemical Vapor Deposition) 法により無機絶縁物質を積層して、ゲート絶縁層22を形成する。ここで、ゲート絶縁層22は、SiNxを用いて約2000の厚さで形成してもよい。

【0054】

その後、第1基板16全体にわたって非晶質シリコン(a-Si)などの半導体物質、IGZOなどの透明酸化物半導体、又は有機物半導体をCVD法により積層した後にエッチングして、半導体層12R、12G、12Bを形成する。そして、図示していないが、半導体層12R、12G、12Bの一部に不純物をドーピングするか、又は不純物が添加された非晶質シリコンを積層して、オーミックコンタクト層を形成してもよい。

【0055】

その後、第1基板16上にCr、Mo、Ta、Cu、Ti、Al、又はAl合金のように導電性に優れた不透明金属をスパッタリング法により積層した後にエッチングして、半導体層12R、12G、12B上、厳密にはオーミックコンタクト層上にソース電極14R、14G、14B及びドレイン電極15R、15G、15Bを形成する。

【0056】

次に、図3Bに示すように、ソース電極14R、14G、14B及びドレイン電極15R、15G、15Bが形成された第1基板16全体にわたって無機絶縁物質を積層して、第1絶縁層24を形成する。ここで、第1絶縁層24は、SiO<sub>2</sub>を用いて約4500の厚さで形成してもよい。その後、第1絶縁層24上のR、G、B画素にそれぞれRカラーフィルタ層17R、Gカラーフィルタ層17G、Bカラーフィルタ層17Bを形成する。

【0057】

次に、図3Cに示すように、Rカラーフィルタ層17R、Gカラーフィルタ層17G、Bカラーフィルタ層17Bが形成された第1基板16全体にわたってフォトアクリルなどの有機絶縁物質を塗布して、第2絶縁層26を積層し、第1絶縁層24及び第2絶縁層26をエッチングして、薄膜トランジスタのドレイン電極15R、15G、15Bを露出するコンタクトホール29 (図3D参照)を形成する。ここで、第2絶縁層26は、約3μ

10

20

30

40

50

mの厚さで形成してもよい。なお、同図においては、第1絶縁層24と第2絶縁層26を同時にエッチングしてコンタクトホール29を形成しているが、第1絶縁層24をエッチングした後にその内部に形成された第2絶縁層26をエッチングしてコンタクトホール29を形成してもよい。

【0058】

その後、第2絶縁層26上にSiNxなどの物質を積層した後にエッチングして、光学補償層27を形成する。ここで、光学補償層27は、コンタクトホール29の内部にも形成されるが、パターニングされてドレイン電極15R、15G、15Bは外部に露出する。

【0059】

光学補償層27はCVD法により形成される。例えば、真空チャンバ内にSiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを供給してCVD法を行うことにより、SiNx層を形成してもよい。

【0060】

もちろん、前記SiNx層は、SiH<sub>4</sub>とNH<sub>3</sub>を混合したガスを用いて形成してもよいが、この場合は、NH<sub>3</sub>に含まれる水素が工程中に薄膜トランジスタのチャネル層に浸透する。このような水素の浸透は、薄膜トランジスタのチャネル層に衝撃を加えて薄膜トランジスタの劣化を起こす主な原因となる。

【0061】

しかし、本発明においては、SiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを用いてSiNx層を形成するため、水素が工程中に薄膜トランジスタのチャネル層に浸透せず、その結果、水素の浸透による薄膜トランジスタの劣化を防止することができる。

【0062】

一方、本発明においては、SiH<sub>4</sub>とNH<sub>3</sub>を混合したガス及びSiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを交互に供給してCVD法を行うことにより、SiNx層を形成してもよい。SiNx層を形成する際にSiH<sub>4</sub>とNH<sub>3</sub>を混合したガス及びSiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを交互に供給してCVD法を行うほうが、SiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを供給してCVD法を行うより、成膜速度が速い。つまり、本発明においては、成膜速度を向上させて工程が円滑に行われるようにすると共に、光学補償層27の水素含有量を最小限に抑えることにより、薄膜トランジスタの劣化を防止することができる。

【0063】

次に、図3Dに示すように、光学補償層27上にITOやIZOなどの透明な導電物質をスパッタリング法により積層した後にエッチングして、画素電極21R、21G、21Bを形成する。ここで、画素電極21R、21G、21Bは、コンタクトホール29の内部に延びて駆動薄膜トランジスタのドレイン電極15R、15G、15Bと電氣的に接続される。また、該当画素の画素電極21R、21G、21Bは、隣接する画素の画素電極21R、21G、21Bとは電氣的に絶縁される。

【0064】

次に、図3Eに示すように、画素と画素との間にバンク層28を形成する。バンク層28は、各画素を区画して隣接する画素から出力される特定のカラーの光が混合されて出力されることを防止し、コンタクトホール29の一部を埋めて段差を減少させる。バンク層28は、無機絶縁物質をCVD法により積層した後にエッチングして形成してもよく、有機絶縁物質を積層した後にエッチングして形成してもよい。

【0065】

その後、バンク層28及び画素電極21R、21G、21Bが形成された第1基板16全体にわたって有機発光部23を形成する。有機発光部23は、電子注入層、電子輸送層、白色有機発光層、正孔輸送層、及び正孔注入層からなり、前記白色有機発光層は、R有機発光物質、G有機発光物質、B有機発光物質が混合された層でもよく、R有機発光層、G有機発光層、B有機発光層が積層された構造でもよい。前記電子注入層、電子輸送層、有機発光層、正孔輸送層、及び正孔注入層は、現在使用されている様々な物質を積層して形成してもよい。

10

20

30

40

50

## 【0066】

その後、有機発光部23上にCa、Ba、Mg、Al、Agなどの金属を積層して、共通電極25を形成する。

## 【0067】

次に、図3Fに示すように、第2基板50全体にわたってエポキシ系化合物、アクリレート系化合物、又はアクリル系ゴムなどの熱硬化性樹脂からなる接着層42を約5～100μmの厚さで形成し、その後、第2基板50を第1基板16上に配置した状態で第1基板16及び第2基板50に圧力を加えることにより、第1基板16と第2基板50とを貼り合わせる。

## 【0068】

ここで、前記接着剤又は接着フィルムを第1基板16上に塗布又は貼付し、その上に第2基板50を配置して貼り合わせてもよい。

## 【0069】

第2基板50としては、ガラスやプラスチックを使用してもよく、PSフィルム、PEフィルム、PENフィルム、又はPIフィルムなどの保護フィルムを使用してもよい。

## 【0070】

前記のように第1基板16と第2基板50とを貼り合わせた後、接着層42を約80～170度の温度に加熱して接着層42を硬化する。このような接着層42の硬化により有機電界発光表示素子がシールされ、外部から水分などが浸透することが防止される。また、第2基板50は、有機電界発光表示素子を封止するための封止キャップとして作用し、有機電界発光表示素子を保護する。

## 【0071】

前述したように、本発明においては、有機発光部23の下部に光学補償層27を形成して有機発光部23から発光する光を屈折させることにより、R、G、Bカラーフィルタ層17R、17G、17Bを透過する光の色視野角を向上させることができる。また、本発明においては、光学補償層27としてSiNxを使用し、かつ当該SiNx層を、SiH<sub>4</sub>とNH<sub>3</sub>を混合したガス雰囲気ではなく、SiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガス雰囲気中で形成することにより、光学補償層27を形成する際に薄膜トランジスタに水素が浸透して薄膜トランジスタが劣化することを効果的に防止することができる。

## 【0072】

図4は、本発明の第2の実施の形態による有機電界発光表示素子の構造を示す断面図である。なお、第2の実施の形態の構造は図2に示す第1の実施の形態の構造と類似しているので、同じ構造については簡単に説明し、異なる構造については詳細に説明する。

## 【0073】

図4に示すように、第1基板116のR、G、B画素にそれぞれ形成された駆動薄膜トランジスタは、第1基板116上のR、G、B画素にそれぞれ形成されたゲート電極111R、111G、111Bと、ゲート電極111R、111G、111B上に形成された半導体層112R、112G、112Bと、半導体層112R、112G、112B上に形成されたソース電極114R、114G、114B及びドレイン電極115R、115G、115Bとからなる。

## 【0074】

前記駆動薄膜トランジスタが形成された第1基板116には第1絶縁層124が形成される。第1絶縁層124は、SiO<sub>2</sub>などの無機絶縁物質を用いて約4500の厚さで形成してもよい。第1絶縁層124上のR、G、B画素には、それぞれRカラーフィルタ層117R、Gカラーフィルタ層117G、Bカラーフィルタ層117Bが形成される。Rカラーフィルタ層117R、Gカラーフィルタ層117G、Bカラーフィルタ層117B上には第2絶縁層126が形成される。

## 【0075】

第2絶縁層126上には光学補償層127が形成される。光学補償層127は、1.5～2.7の屈折率を有する物質であり、SiNx、ITOやIZOなどの透明物質を使用

10

20

30

40

50

してもよい。ここで、光学補償層 127 は、水素を含有しない層であり、光学補償層 127 として SiN<sub>x</sub> 層などを形成する際に、水素を含まない雰囲気中で形成することにより、薄膜トランジスタのチャネル層に水素が浸透して薄膜トランジスタが劣化することを防止することができる。本実施の形態においては、光学補償層 127 に水素を含有することもある。

#### 【0076】

光学補償層 127 には複数の孔 127a が形成される。複数の孔 127a は各画素領域の外周壁に形成されている。孔 127a は、第 2 絶縁層 126 又は他の層で発生する異物を排出する。後述するが、光学補償層 127 の上部には有機発光層が形成されるが、当該有機発光層を形成する前に、有機発光層の下部に形成された層の異物などを除去するために、真空状態で下部層を所定時間露出する真空キュア工程を行う。このような真空キュア工程で、第 2 絶縁層 126 などで発生する異物をガスの形で外部に排出しなければならないが、光学補償層 127 が形成されている場合は、異物が排出されなくなり、不良が発生する。

10

#### 【0077】

本発明においては、光学補償層 127 に複数の孔 127a を形成することにより、真空キュア時に孔 127a から異物が排出されるようにする。ここで、孔 127a は、光学補償層 127 全体にわたって形成してもよく、R、G、B 画素に対応する光学補償層 127 の領域にのみ形成してもよく、規則的に形成してもよく、不規則的に形成してもよい。

20

#### 【0078】

光学補償層 127 上の R、G、B 画素にはそれぞれ画素電極 121R、121G、121B が形成される。このとき、R、G、B 画素にそれぞれ形成された駆動薄膜トランジスタのドレイン電極 115R、115G、115B の上部の第 1 絶縁層 124 及び第 2 絶縁層 126 にはコンタクトホール 129 が形成されており、光学補償層 127 及び画素電極 121R、121G、121B がコンタクトホール 129 (図 5D 参照) に形成され、画素電極 121R、121G、121B は、それぞれ露出した駆動薄膜トランジスタのドレイン電極 115R、115G、115B と電氣的に接続される。

#### 【0079】

また、第 2 絶縁層 126 上の各画素境界領域にはバンク層 128 が形成される。光学補償層 127 及びバンク層 128 上には、白色光を発光する有機発光部 123 が形成され、有機発光部 123 上には、第 1 基板 116 全体にわたって共通電極 125 が形成される。

30

#### 【0080】

共通電極 125 上に接着剤が塗布されて接着層 142 が形成され、接着層 142 上に第 2 基板 150 が配置され、接着層 142 により第 2 基板 150 が第 1 基板 116 に貼り付けられることにより、有機電界発光表示素子が完成する。

#### 【0081】

以下、このような構造の本発明の第 2 の実施の形態による有機電界発光表示素子の製造方法を説明する。

#### 【0082】

図 5A ~ 図 5F は、本発明の第 2 の実施の形態による有機電界発光表示素子の製造方法を示す図である。

40

#### 【0083】

まず、図 5A に示すように、第 1 基板 116 を準備し、その上に導電性に優れた不透明金属をスパッタリング法により積層し、フォトリソグラフィ法によりエッチングして、ゲート電極 111R、111G、111B を形成する。

#### 【0084】

その後、ゲート電極 111R、111G、111B が形成された第 1 基板 116 全体にわたって無機絶縁物質を積層して、ゲート絶縁層 122 を形成し、第 1 基板 116 全体にわたって非晶質シリコン (a-Si) などの半導体物質、IGZO などの透明酸化物半導体、又は有機物半導体を CVD 法により積層した後にエッチングして、半導体層 112R

50

、112G、112Bを形成する。そして、図示していないが、半導体層112R、112G、112Bの一部に不純物をドーピングするか、又は不純物が添加された非晶質シリコンを積層して、オーミックコンタクト層を形成してもよい。

【0085】

その後、第1基板116上に導電性に優れた不透明金属をスパッタリング法により積層した後にエッチングして、半導体層112R、112G、112B上、厳密にはオーミックコンタクト層上にソース電極114R、114G、114B及びドレイン電極115R、115G、115Bを形成する。

【0086】

次に、図5Bに示すように、ソース電極114R、114G、114B及びドレイン電極115R、115G、115Bが形成された第1基板116全体にわたって無機絶縁物質を積層して第1絶縁層124を形成し、第1絶縁層124上にそれぞれRカラーフィルタ層117R、Gカラーフィルタ層117G、Bカラーフィルタ層117Bを形成する。

10

【0087】

次に、図5Cに示すように、Rカラーフィルタ層117R、Gカラーフィルタ層117G、Bカラーフィルタ層117Bが形成された第1基板116全体にわたって、第2絶縁層126を積層し、第1絶縁層124及び第2絶縁層126をエッチングして、薄膜トランジスタのドレイン電極115R、115G、115Bを露出するコンタクトホール129を形成する。なお、同図においては、第1絶縁層124と第2絶縁層126を同時にエッチングしてコンタクトホール129を形成しているが、第1絶縁層124を形成してから第1絶縁層124をエッチングしてコンタクトホールを形成し、その後、第2絶縁層126を形成してから第2絶縁層126をエッチングしてコンタクトホールを形成することにより、第1絶縁層124及び第2絶縁層126にコンタクトホール129を形成してもよい。

20

【0088】

その後、第2絶縁層126上にSiNxなどの物質を積層した後にエッチングして光学補償層127を形成し、光学補償層127に複数の孔127aを形成する。同図において、孔127aは、R、G、B画素に対応する光学補償層127の領域にのみ形成しているが、光学補償層127全体にわたって形成してもよい。

【0089】

光学補償層127はCVD法により形成される。例えば、真空チャンバ内にSiH<sub>4</sub>とNH<sub>3</sub>を混合したガスを供給してCVD法を行うことにより、SiNx層を形成してもよく、真空チャンバ内にSiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを供給してCVD法を行うことにより、SiNx層を形成してもよい。また、SiH<sub>4</sub>とNH<sub>3</sub>を混合したガス及びSiH<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>を混合したガスを交互に供給してCVD法を行うことにより、SiNx層を形成してもよい。

30

【0090】

次に、図5Dに示すように、光学補償層127上にITOやIZOなどの透明な導電物質を積層した後にエッチングして、画素電極121R、121G、121Bを形成する。

【0091】

次に、図5Eに示すように、画素と画素との間にバンク層128を形成し、その後、バンク層128及び画素電極121R、121G、121Bが形成された第1基板116全体にわたって有機発光部123を形成する。有機発光部123は、電子注入層、電子輸送層、白色有機発光層、正孔輸送層、及び正孔注入層からなり、前記白色有機発光層は、R有機発光物質、G有機発光物質、B有機発光物質が混合された層でもよく、R有機発光層、G有機発光層、B有機発光層が積層された構造でもよい。前記電子注入層、電子輸送層、有機発光層、正孔輸送層、及び正孔注入層は、現在使用されている様々な物質を積層して形成してもよい。

40

【0092】

図示していないが、バンク層128を形成してから有機発光部123を形成する前に、

50

形成された層を所定時間真空にさらして真空キュアを行う。

【0093】

その後、有機発光部123上にCa、Ba、Mg、Al、Agなどの金属を積層して、共通電極125を形成する。

【0094】

次に、図5Fに示すように、第2基板150全体にわたって接着層142を形成し、その後、第2基板150を第1基板116上に配置した状態で第1基板116及び第2基板150に圧力を加えることにより、第1基板116と第2基板150とを貼り合わせる。ここで、前記接着剤又は接着フィルムを第1基板116上に塗布又は貼付し、その上に第2基板150を配置して貼り合わせてもよい。

10

【0095】

前記のように第1基板116と第2基板150とを貼り合わせた後、接着層142を約80～170度の温度に加熱して接着層142を硬化することにより、有機電界発光表示素子を完成する。

【0096】

前述した詳細な説明においては、有機電界発光表示素子として特定の構造の有機電界発光表示素子が提示されているが、本発明がこのような特定の構造の有機電界発光表示素子に限定されるものではない。

【0097】

例えば、前述した詳細な説明においては、有機発光部が電子注入層、電子輸送層、有機発光層、正孔輸送層、及び正孔注入層からなるが、有機発光部は、有機発光層のみからなるようにしてもよく、電子注入層及び有機発光層のみからなるようにしてもよく、有機発光層及び正孔注入層のみからなるようにしてもよく、他にも様々な構成が可能である。

20

【0098】

つまり、本発明の要旨といえる、水素含有量を最小限に抑えて光学補償層を形成することができ、光学補償層に複数の孔を形成することができるものであれば、既知の全ての構造の有機電界発光表示素子に適用できるであろう。

【符号の説明】

【0099】

- 16 第1基板
- 50 第2基板
- 17R, 17G, 17B カラーフィルタ層
- 21R, 21G, 21B 画素電極
- 23 有機発光部
- 24 第1絶縁層
- 26 第2絶縁層
- 25 共通電極
- 27 光学補償層
- 28 バンク層
- 42 接着層
- 116 第1基板
- 150 第2基板
- 117R, 117G, 117B カラーフィルタ層
- 121R, 121G, 121B 画素電極
- 123 有機発光部
- 124 第1絶縁層
- 126 第2絶縁層
- 125 共通電極
- 127 光学補償層
- 128 バンク層

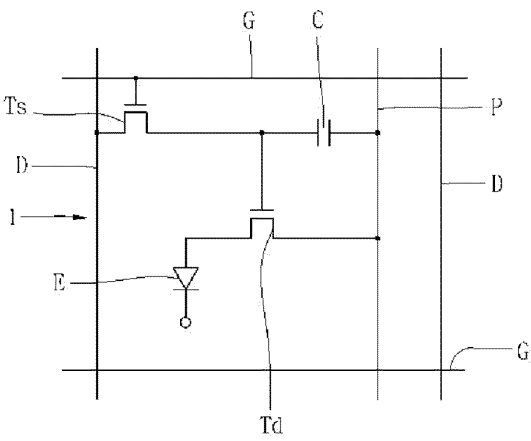
30

40

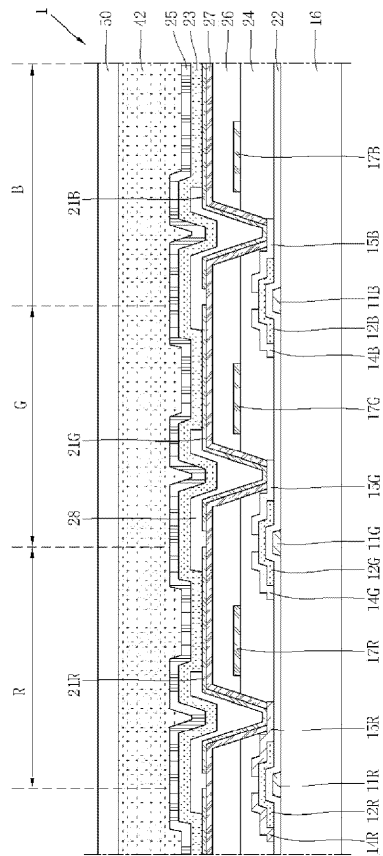
50

1 4 2 接着層

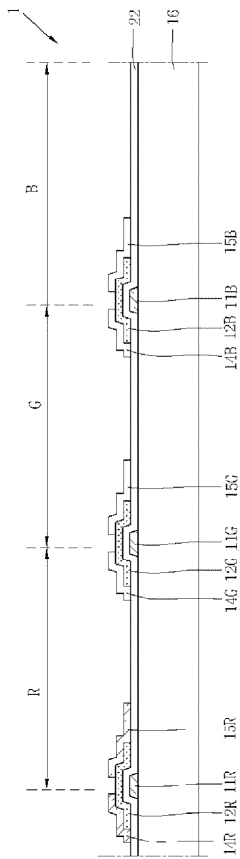
【 図 1 】



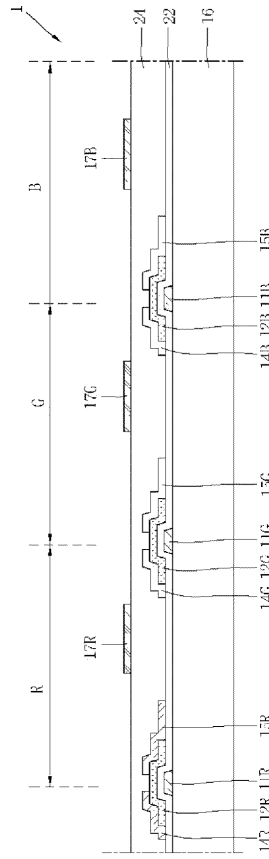
【 図 2 】



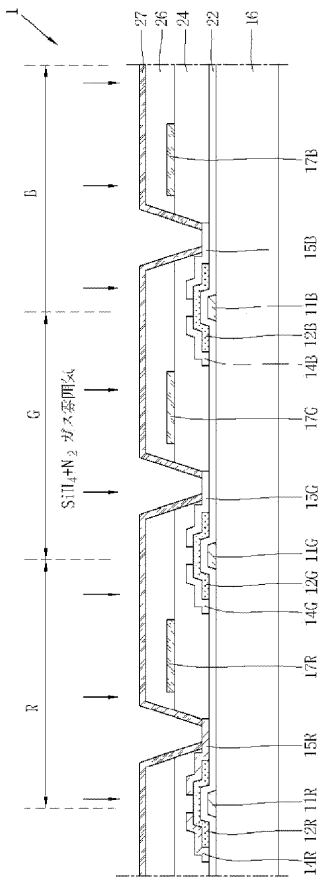
【図 3 A】



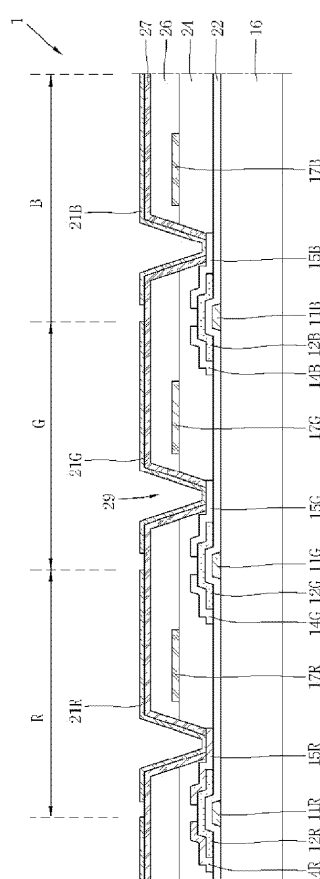
【図 3 B】



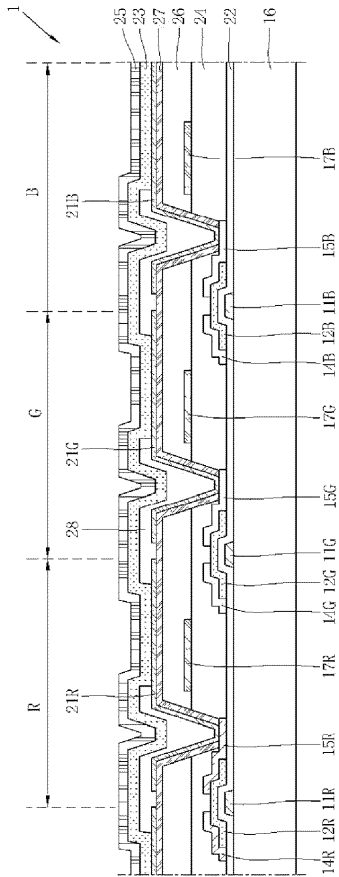
【図 3 C】



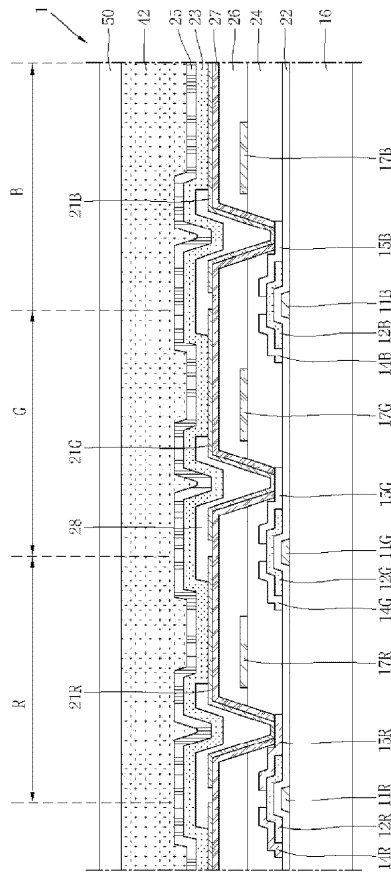
【図 3 D】



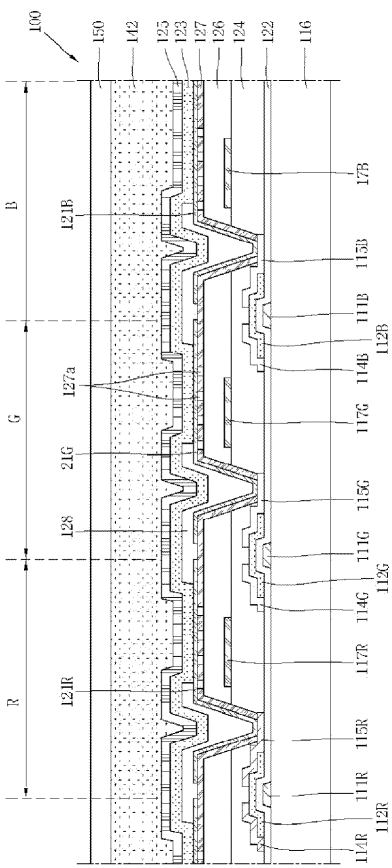
【 図 3 E 】



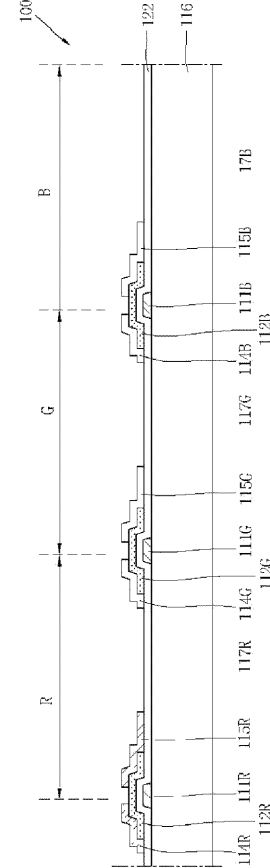
【 図 3 F 】



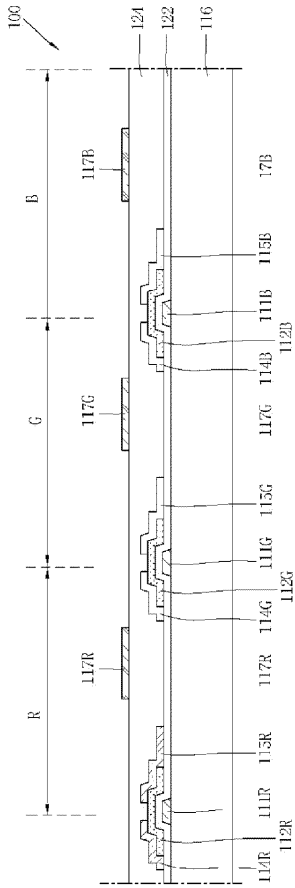
【 図 4 】



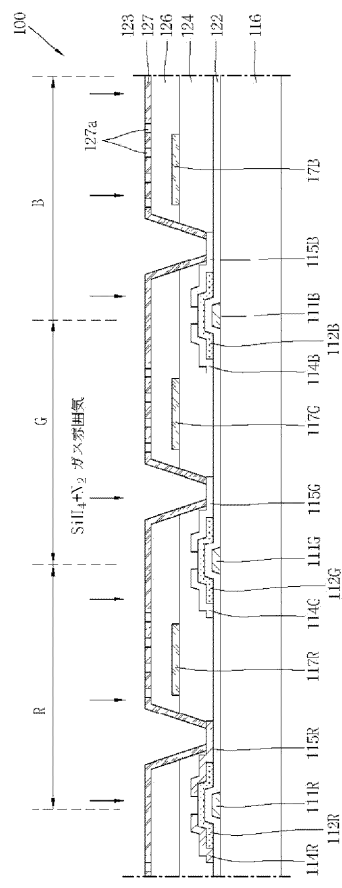
【 図 5 A 】



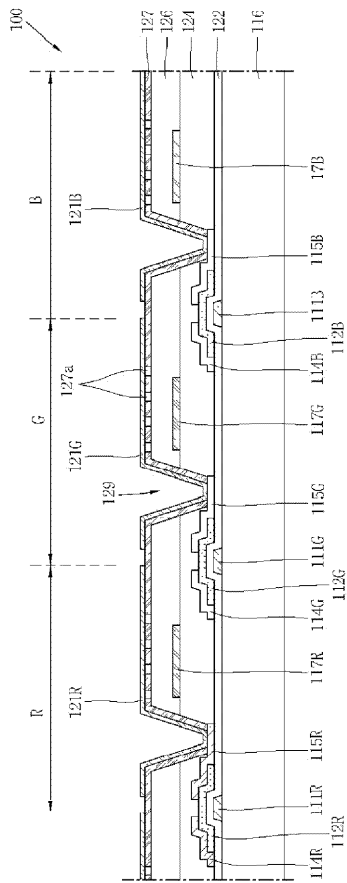
【図 5 B】



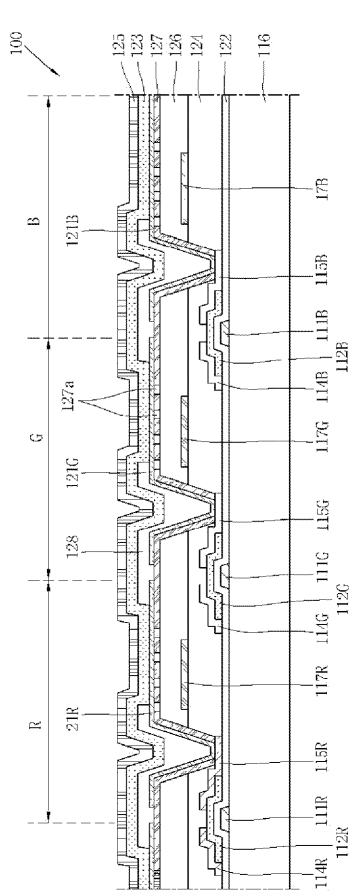
【図 5 C】



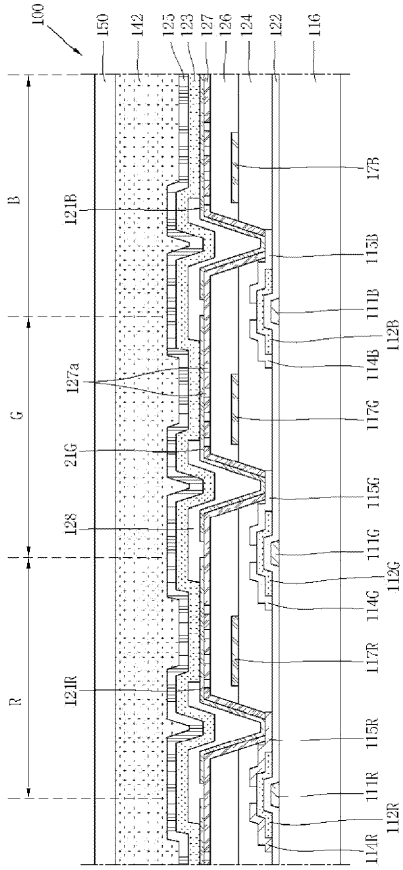
【図 5 D】



【図 5 E】



【 図 5 F 】



## フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	テーマコード(参考)
<b>H 0 5 B 33/02 (2006.01)</b>		H 0 5 B 33/02	
<b>H 0 5 B 33/10 (2006.01)</b>		H 0 5 B 33/10	

(72)発明者 徐 鉉 植

大韓民国 京畿道 高陽市 一山東區 馬頭洞 鼎鉢建榮 アパート 7 0 3 - 2 0 1

(72)発明者 李 政 訓

大韓民国 慶尚北道 龜尾市 松亭洞 キャッスル アパート 1 2 3 - 1 0 0 4

(72)発明者 金 大 元

大韓民国 京畿道 高陽市 徳陽區 幸信洞 セムト - 住公 アパート 2 1 3 - 1 0 2

(72)発明者 崔 容 豪

大韓民国 ソウル 銅雀區 黒石3洞 2 0 1 6 9 - 4 4

Fターム(参考) 2H048 BB02 BB41

3K107 AA01 BB01 CC23 CC37 DD02 DD22 DD28 DD90 EE04 EE21  
 EE22 FF15 GG02 GG12 GG22 GG28 HH05

专利名称(译)	有机电致发光显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	<a href="#">JP2013125746A</a>	公开(公告)日	2013-06-24
申请号	JP2012237516	申请日	2012-10-29
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	Eruji显示有限公司		
[标]发明人	徐鉉植 李政訓 金大元 崔容豪		
发明人	徐鉉植 李政訓 金大元 崔容豪		
IPC分类号	H05B33/04 H01L51/50 H05B33/12 G02B5/20 H05B33/22 H05B33/02 H05B33/10		
CPC分类号	H01L51/5262 H01L27/1248 H01L27/322 H01L27/3272 H01L51/5275		
FI分类号	H05B33/04 H05B33/14.A H05B33/12.E G02B5/20.101 H05B33/22.Z H05B33/02 H05B33/10		
F-TERM分类号	2H048/BB02 2H048/BB41 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC37 3K107/DD02 3K107/DD22 3K107/DD28 3K107/DD90 3K107/EE04 3K107/EE21 3K107/EE22 3K107/FF15 3K107/GG02 3K107/GG12 3K107/GG22 3K107/GG28 3K107/HH05 2H148/BB01 2H148/BB03 2H148/BD05 2H148/BD14 2H148/BD18 2H148/BD22 2H148/BG06 2H148/BH01 2H148/BH11 2H148/BH28		
代理人(译)	吉泽博 ▲滨▼口 岳久		
优先权	1020110134862 2011-12-14 KR		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机电致发光显示元件及其制造方法，能够防止在形成光学补偿层时由于氢的渗透而导致的薄膜晶体管的劣化，从而改善视角特性。解决方案：有机电致发光显示元件包括：第一基板16，包括多个像素；以及第二基板50；形成于第一基板16的每个像素的薄膜晶体管；形成每个像素的滤色器层17R，17G和17B；绝缘层26形成在滤色器层17R，17G和17B上；光学补偿层27形成在绝缘层26上并由不含氢的物质制成；像素电极21R，21G和21B形成在每个像素的光学补偿层27上；有机发光部分23形成在像素电极21R，21G和21B上以发光；形成在有机发光部分23上的公共电极25。

